

Germanium PNP Transistor

GS112

20V / 200mA

DATASHEET

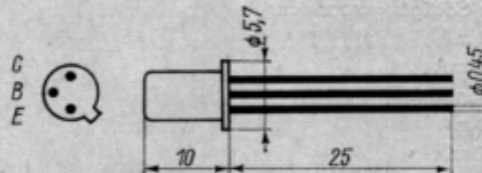
OEM – RFT

Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72

RFT
electronic

GS 112

Germanium-pnp-Schalttransistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 mit hoher Basis-Emitter-Spannungsfestigkeit für mittlere Geschwindigkeiten in logischen Schaltungen.



Masse ca. 0,8 g

Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CB0}$	= 20 V
Kollektor-Emitter-Spannung $R_{BE} = 50 \Omega$	$-U_{CER}$	= 15 V ¹⁾
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	= 10 V
Kollektorstrom $t_{avL} = 20 \text{ ms}$	$-I_{CL}$	= 200 mA
Kollektorspitzenstrom	$\hat{-I}_{CL}$	= 300 mA
Emitterstrom	I_{EL}	= 200 mA
Sperrschichttemperatur	ϑ_{jL}	= 85 °C
Umgebungstemperatur	ϑ_{mL}	= 65 °C ²⁾
Wärmewiderstand	R_{thjc}	≤ 0,5 grad/mW



KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Stambetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

4.70

147

GS 112		RFT electronic		
Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$			15 μ A
$-U_{CB} = 15$ V				
$\theta_a = 25$ °C				
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$			80 μ A
$-U_{CB} = 15$ V				
$\theta_a = 45$ °C				
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$			800 μ A
$-U_{CB} = 15$ V				
$\theta_a = 75$ °C				
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$-U_{CEsat}$			0,3 V
$-I_B = 9,4$ mA				
$-I_C = 300$ mA				
Basis-Emitter-Spannung	$-U_{BE}$			0,8 V
$-I_B = 9,4$ mA				
$-I_C = 300$ mA				
Dynamische Kennwerte				
Kurzschlußstromverstärkung	h_{21E}	28		56
$-U_{CE} = 0,5$ V		45		90
$-I_C = 200$ mA		71		140
Einschaltzeitkonstante	τ_i			1,2 μ s
$-U_{CE} = 0,5$ V				
$-I_C = 200$ mA				
Speicherzeit	t_s			0,9 μ s
$-I_B = 9,4$ mA				
$-I_C = 300$ mA				
Bemerkungen:				
1) Beim Umschalten des Transistors aus dem „Ein“-Zustand (max. Verlustleistung, $\hat{I}_{CL} = 300$ mA) in den Sperrzustand ($-U_{CER} = 15$ V, $R_{BE} = 50 \Omega$) darf die Widerstandsgerade zwischen beiden Schaltzuständen die Sperrkennlinie des Transistors nicht im negativen Widerstandsbereich schneiden.				
2) Maximale Lagerungstemperatur und maximale Umgebungstemperatur im Betriebsfall unter Berücksichtigung der zulässigen Verlustleistung.				
Bestellbeispiel für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe C				Transistor GS 112 C
4.70	KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)			
148	Stammbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)			